
	<h2 style="color: red;">FQD20N06TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD20N06TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD20N06TM.pdf 2.FQD20N06TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8322 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8322 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 8.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD20N06TM ist neu im Original, Suche FQD20N06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD20N06LTU VB FQD20N06LTU VB</p>	 <p>FQD20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD20N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>
 <p>FQD20N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD24N08 FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM	D FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TF
⊣ FQD1N60TM	⊗ FQD1N60TM	D FQD1N80TM	⇒ FQD1N80TM	⇒ FQD1P50TM
⊗ FQD1P50TM	⊣ FQD20N06	⊗ FQD20N06-NL	↔ FQD20N06L	⇒ FQD20N06LE
D FQD20N06LETM	⊗ FQD20N06LETM	⊣ FQD20N06LTF	⊗ FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTM
⇒ FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTU	⊗ FQD20N06TF	⊣ FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TM
↔ FQD24N08	⇒ FQD24N08TF	D FQD24N08TF	⊗ FQD24N08TM	⊣ FQD24N08TM
⊗ FQD2N100	D FQD2N100TM	⇒ FQD2N100TM	↔ FQD2N30TF	⇒ FQD2N40TM
⊣ FQD2N40TM	⊗ FQD2N50B	↔ FQD2N50C	⇒ FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TF
⊗ FQD2N50TM	⊣ FQD2N50TM	⊗ FQD2N60A	D FQD2N60C	⇒ FQD2N60CTF
↔ FQD2N60CTF	⊗ FQD2N60CTF-NL	⊣ FQD2N60CTF_F080	⊗ FQD2N60CTF_F080	⇒ FQD2N60CTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited